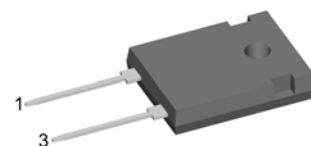


Sonic Fast Recovery Diode

High Performance Fast Recovery Diode
Low Loss and Soft Recovery
Single Diode

Part number

DHG 30 I 1200 HA



Backside: cathode

Features / Advantages:

- Planar passivated chips
- Very low leakage current
- Very short recovery time
- Improved thermal behaviour
- Very low I_{RM} -values
- Very soft recovery behaviour
- Avalanche voltage rated for reliable operation
- Soft reverse recovery for low EMI/RFI
- Low I_{RM} reduces:
 - Power dissipation within the diode
 - Turn-on loss in the commutating switch

Applications:

- Antiparallel diode for high frequency switching devices
- Antisaturation diode
- Snubber diode
- Free wheeling diode
- Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
- Uninterruptible power supplies (UPS)

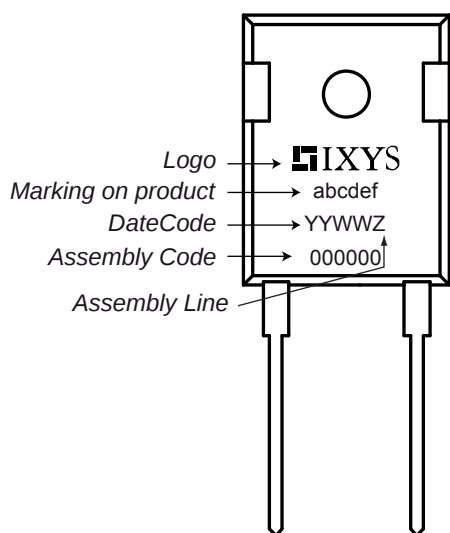
Package:

- Housing: TO-247
- Industry standard outline
- Epoxy meets UL 94V-0
- RoHS compliant

Ratings

Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
V_{RRM}	max. repetitive reverse voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			1200	V
I_R	reverse current	$V_R = 1200\text{ V}$ $T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			50	μA
		$V_R = 1200\text{ V}$ $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$			0.5	mA
V_F	forward voltage	$I_F = 30\text{ A}$ $T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		1.95	2.26	V
		$I_F = 60\text{ A}$ $T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			3.00	V
		$I_F = 30\text{ A}$ $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$		1.95	2.27	V
		$I_F = 60\text{ A}$ $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$			3.20	V
I_{FAV}	average forward current	rectangular $d = 0.5$ $T_C = 90^{\circ}\text{C}$			30	A
V_{F0}	threshold voltage	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$ for power loss calculation only			1.25	V
r_F	slope resistance				30	m Ω
R_{thJC}	thermal resistance junction to case				0.70	K/W
T_{VJ}	virtual junction temperature		-55		150	$^{\circ}\text{C}$
P_{tot}	total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$			180	W
I_{FSM}	max. forward surge current	$t = 10\text{ ms}$ (50 Hz), sine $T_{VJ} = 45^{\circ}\text{C}$			200	A
I_{RM}	max. reverse recovery current	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		23		A
		$I_F = 30\text{ A}; V_R = 600\text{ V}$ $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$		30		A
t_{rr}	reverse recovery time	$-di_F/dt = 600\text{ A}/\mu\text{s}$ $T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		200		ns
		$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$		350		ns
C_J	junction capacitance	$V_R = 600\text{ V}; f = 1\text{ MHz}$ $T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		11		pF

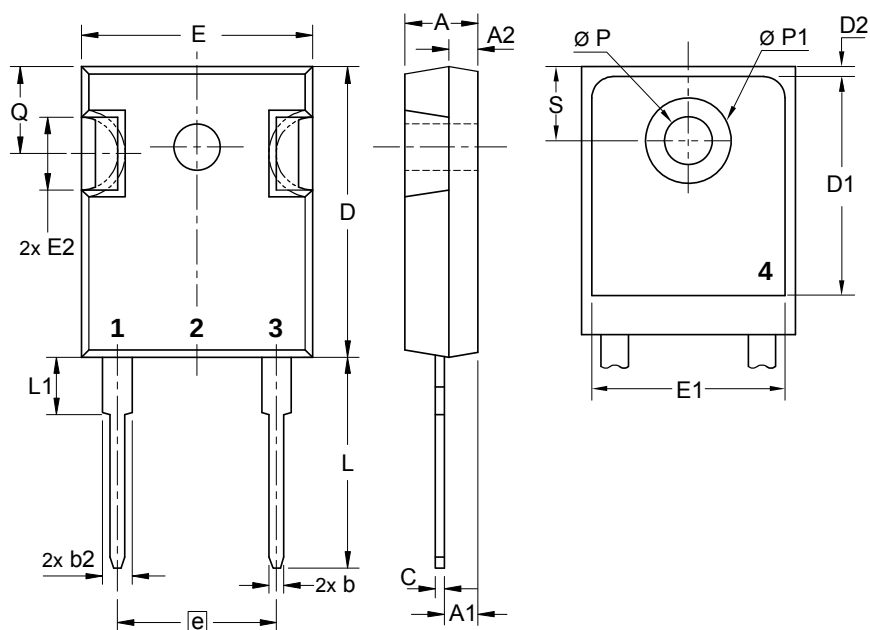
Symbol	Definition	Conditions	Ratings			Unit
			min.	typ.	max.	
I_{RMS}	RMS current	per terminal			70	A
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink			0.25		K/W
T_{stg}	storage temperature		-55		150	°C
Weight				6		g
M_D	mounting torque		0.8		1.2	Nm
F_c	mounting force with clip		20		120	N

Product Marking

Part number

D = Diode
 H = Sonic Fast Recovery Diode
 G = extreme fast
 30 = Current Rating [A]
 I = Single Diode
 1200 = Reverse Voltage [V]
 HA = TO-247AD (2)

Ordering	Part Name	Marking on Product	Delivering Mode	Base Qty	Code Key
Standard	DHG 30 I 1200 HA	DHG30I1200HA	Tube	30	503098

Similar Part	Package	Voltage Class
DSEP30-12A	TO-247AD (2)	1200
DSEP29-12A	TO-220AC (2)	1200
DSEP30-12AR	ISOPLUS247 (2)	1200
DSEP30-12CR	ISOPLUS247 (2)	1200

Outlines TO-247


Sym.	Inches		Millimeter	
	min.	max.	min.	max.
A	0.185	0.209	4.70	5.30
A1	0.087	0.102	2.21	2.59
A2	0.059	0.098	1.50	2.49
D	0.819	0.845	20.79	21.45
E	0.610	0.640	15.48	16.24
E2	0.170	0.216	4.31	5.48
e	0.430	BSC	10.92	BSC
L	0.780	0.800	19.80	20.30
L1	-	0.177	-	4.49
Ø P	0.140	0.144	3.55	3.65
Q	0.212	0.244	5.38	6.19
S	0.242	BSC	6.14	BSC
b	0.039	0.055	0.99	1.40
b2	0.065	0.094	1.65	2.39
b4	0.102	0.135	2.59	3.43
c	0.015	0.035	0.38	0.89
D1	0.515	-	13.07	-
D2	0.020	0.053	0.51	1.35
E1	0.530	-	13.45	-
Ø P1	-	0.29	-	7.39

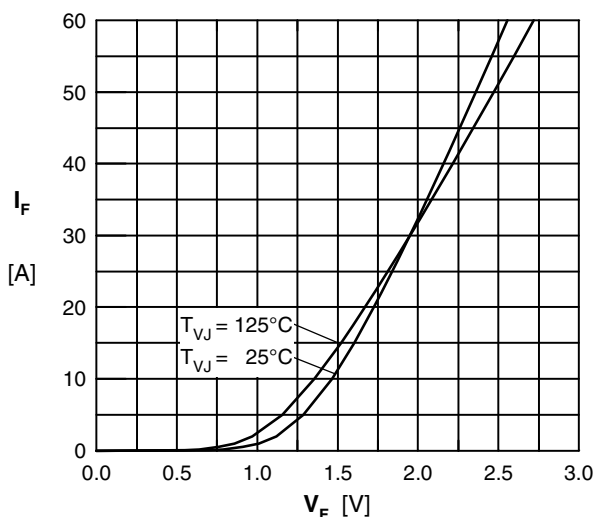


Fig. 1 Typ. Forward current versus V_F

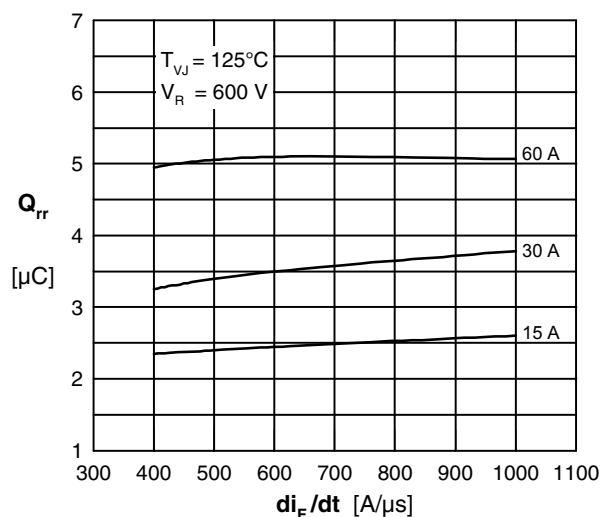


Fig. 2 Typ. reverse recov.charge Q_{rr} vs. di/dt

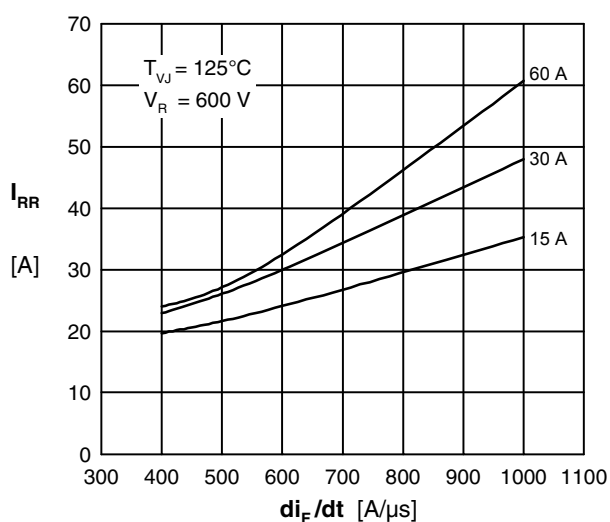


Fig. 3 Typ. peak reverse current I_{RM} vs. di/dt

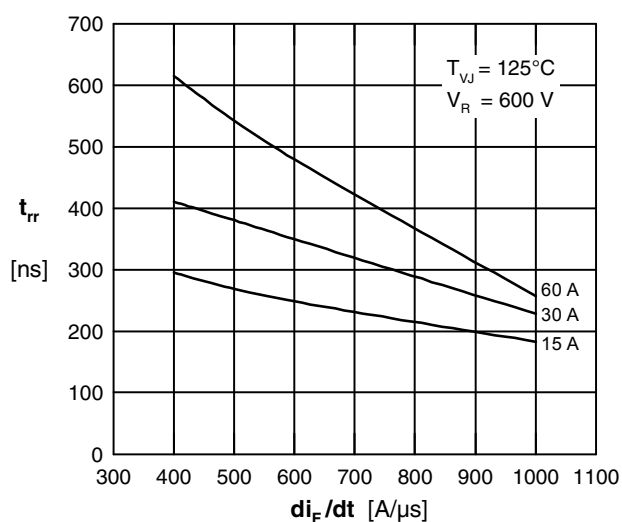


Fig. 4 Typ. recovery time t_{rr} versus di/dt

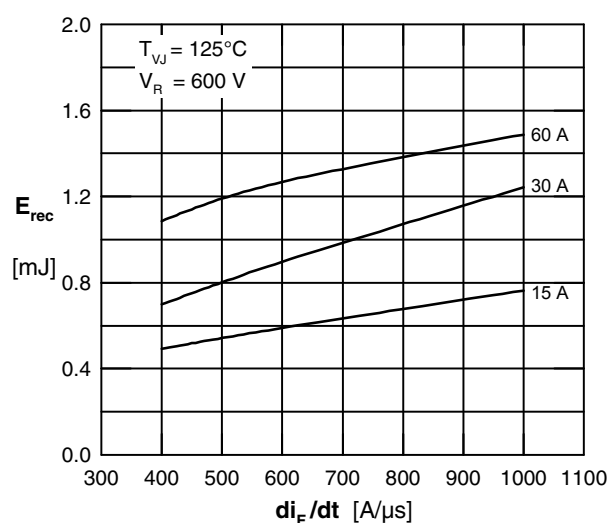


Fig. 5 Typ. recovery energy E_{rec} versus di/dt

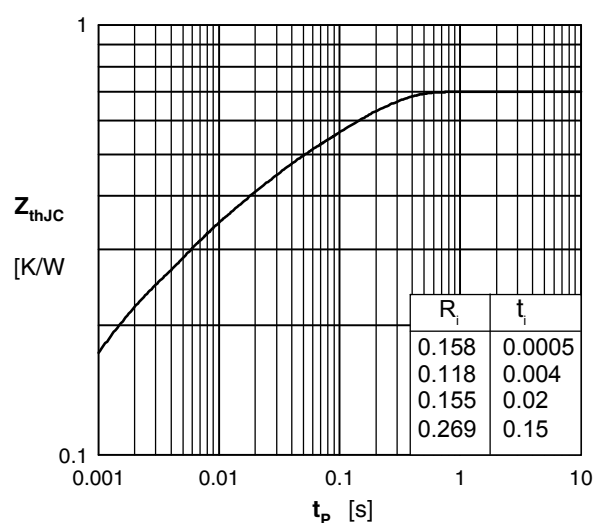


Fig. 6 Transient thermal impedance

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9